

PUBLICATION NUMBER : 04116849
PUBLICATION DATE : 17-04-92

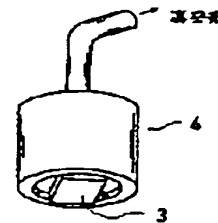
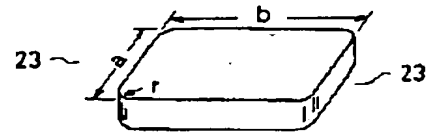
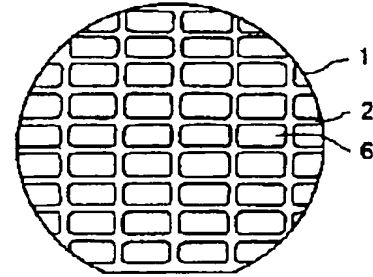
APPLICATION DATE : 06-09-90
APPLICATION NUMBER : 02236424

APPLICANT : TOSHIBA CORP;

INVENTOR : TATEMATSU MIKIO;

INT.CL. : H01L 21/78

TITLE : SEMICONDUCTOR DEVICE



ABSTRACT : **PURPOSE:** To prevent the occurrence of chipping in a semiconductor element even when the semiconductor element is mounted with vacuum forceps by forming the rectangular semiconductor element with four round corners.

CONSTITUTION: A semiconductor element 23 is formed to have round sections at its four corners. In order to form the element 23 in such way, a wafer 1 is irradiated with ultraviolet rays through a photomask so as to expose a novolak type photoresist 6 applied to sections other than those to be left for semiconductor elements 23 after the photoresist 6 is applied to the surface of the wafer 1. The photoresist is developed after exposure. When the pattern of the photomask is formed in accordance with the shape of the semiconductor elements having four round corners, the pattern of the photoresist 6 can be formed. Then the semiconductor elements 23 are obtained from the wafer 1 in such a way that the wafer 1 is divided into the elements 23 by selectively etching the wafer 1 with a reactive gas containing BCl_3 and Cl_3 by using the photoresist 6 as etching masks and the photoresist is removed by dissolving the photoresist in an organic solvent. Therefore, the occurrence of chipping in the semiconductor elements composed of a compound semiconductor can be prevented even when the elements are handled with vacuum forceps.

COPYRIGHT: (C)1992,JPO&Japio

9163

11336-EP H-742-6

⑨ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A)

平4-116849

⑬ Int. Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

⑭ 公開 平成4年(1992)4月17日

H 01 L 21/78

R

6940-4M

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

⑮ 発明の名称 半導体装置

⑯ 特 願 平2-236424

⑰ 出 願 平2(1990)9月6日

⑱ 発 明 者 立 松 幹 雄 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝小向工場内

⑲ 出 願 人 株 式 会 社 東 芝 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

⑳ 代 理 人 弁 理 士 大 胡 典 夫

明 細 書

1. 発明の名称

半導体装置

2. 特許請求の範囲

化合物半導体ウエーハを長方形に分割して得られる半導体素子を備えた半導体装置において、半導体素子における長方形の角部が丸く形成されてなることを特徴とする半導体装置。

3. 発明の詳細な説明

(発明の目的)

(産業上の利用分野)

本発明は、例えば砒化ガリウムGaAs半導体を用いる電界効果トランジスタ(以下FETと称す)やモノリシック・マイクロ波集積回路(以下MMICと称す)等の半導体装置に関する。

(従来技術)

従来、GaAs等の化合物半導体を用いたFET、モノリシック型マイクロ波集積回路(MMICと略称)等は次に述べるように形成されていた。

すなわち、第2図(a)に示されるように、ウ

エーハ1と称する円盤状の半導体基板上に選択的イオン注入、各種電極材料や絶縁体の選択的形成、熱処理等を施して複数個を同時に構成した後、スクライプライン2に沿ってダイヤモンドブレードなどにより分割して個々の半導体素子3(第2図(b))を形成している。

このようにして得られた半導体素子3は、長方形の形状を示している。そして、この半導体素子は、通常パッケージやキャリアプレート上にはんだや接着剤を用いてマウントした後、金線またはアルミ線により半導体素子の電極と外部の電極端子とを接続して実用に供されるが、マウント作業を行なう際には第4図に示すように、半導体素子3を真空ピンセット4で取扱うことが多い。

ところが叙上のGaAsなどの化合物半導体は比較的もろい材質であるため、その製造工程において真空ピンセット4と接触した時に、長方形の角部の部分が欠け易いという問題点があった。第3図は、1つの角部の部分に欠損部5が生じた半導体素子13を例示している。このような欠損部5が生

じた半導体素子13は通例、性能の劣化が顕著され、また、直ちに検出されなくても経時的に劣化が進行することが予想されるため、不良品と判定している。

従って上記従来の鋭い角部のある半導体素子ではマウント時に不良品が多く発生するという欠点があった。

(発明が解決しようとする課題)

以上述べたように従来の半導体装置では、その半導体素子はその4つの角部が鋭い角をなしている。その結果、真空ピンセットを用いるマウント時に角に欠損が生じることが避けられず、マウント時の不良発生が多かった。

本発明は上記の欠点を除去すべくなされたもので、真空ピンセットを用いるマウント時における欠損の発生を防ぐようにした半導体素子を備えた半導体装置を提供することを目的とする。

(発明の構成)

(課題を解決するための手段)

本発明に係る半導体装置は、化合物半導体ウ

ェハに接触する部分に鋭い角部がないため、マウント時に欠損が生じることによる不良発生が防止できる。

このような構成を実現するためには、従来のダイヤモンドブレードを用いる分割方法に代えて、異方性のある選択エッチングによる分割方法を採用すればよい。この時に重要なことは、選択エッチングを行う際に用いるマスクを角部にアールを設けた形状に形成することである。具体的には第1図(a)に示すように、ウエーハ1の表面に例えばノボラック系ポジ形フォトレジストを塗布した後、フォトマスクを介して紫外線を照射して半導体素子として残す部分に対応した部分以外のフォトレジストを露光し、現像する。フォトマスクのパターンを半導体素子の4つの角部にアールが設けられた形状に対応させることにより、第1図(a)に示すフォトレジスト6のパターンを形成できる。次にフォトレジスト6をエッチングマスクとして用い、ウエーハにBCl₃とCl₂を含む反応ガスを使った選択エッチングを施して、ウエーハを分割し、

エーハを長方形に分割して得られる半導体素子を備えた半導体装置において、半導体素子における長方形の角部が丸く形成されてなることを特徴とする。

(作用)

本発明の半導体装置では、半導体素子の4つの角部にアールを設けまたは鈍角に形成することにより、真空ピンセットとの接触による欠損を生じにくくなっている。

したがって、真空ピンセットを用いるマウント工程における不良品の発生が防止できる。

(実施例)

以下、本発明に係る半導体装置の一実施例につき図面を参照して説明する。

第1図(b)に示す半導体素子23は4つの角部にアールが設けられたものである。この例では半導体素子の角部が丸められており、そのアールの大きさは一定で、その曲率半径rは半導体素子の短辺(a)の約1/6、長辺(b)の約1/12である。

上記の構成によれば、真空ピンセットで取扱う

さらに、有機溶剤によりフォトレジストを溶解除去して第1図(b)に示す半導体素子23を得ることができる。

(発明の効果)

以上述べたように本発明によれば、真空ピンセットにより取扱う際に化合物半導体からなる半導体素子に欠損が生じることが防止でき、半導体素子をパッケージやキャリアブレードにマウントする際の不良発生が防止できる半導体装置を提供できる。

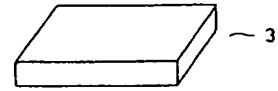
4. 図面の簡単な説明

第1図(a)は本発明に係る半導体素子の一実施例の形成手段を説明するための平面図、第1図(b)は本発明に係る半導体素子の一実施例を示す斜視図、第2図(a)は従来の半導体素子の形成手段を説明するための平面図、第2図(b)は従来の半導体素子を示す斜視図、第3図は従来の半導体素子における欠損を説明するための斜視図、第4図は真空ピンセットによって取扱いされた後の半導体素子の状態を説明するための斜視図である。

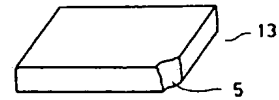
1…ウエーハ、2…スクライブライン、
3, 13, 23…半導体素子、
4…真空ピンセット、5…欠損部。

代理人 弁理士 大 胡 典 夫

(b)

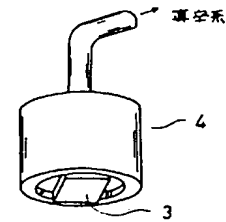


第 2 図 (々の2)



5: 欠損部 13: (欠損を生じた) 半導体素子

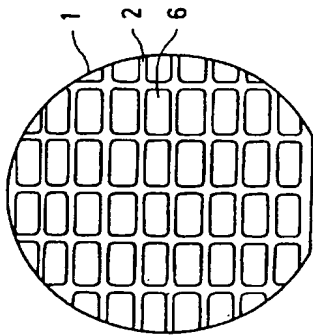
第 3 図



4: 真空ピンセット

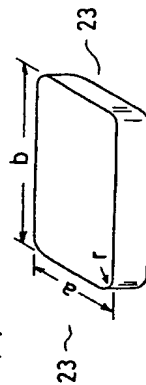
第 4 図

(a)



1: ウエーハ 2: スクライブライン 6: フォトリソ

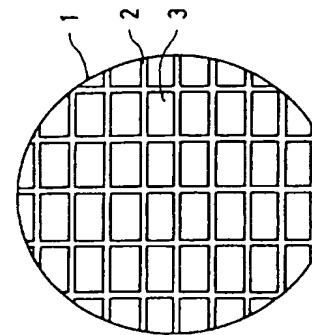
(b)



23: 半導体素子

第 1 図

(a)



1: ウエーハ 2: スクライブライン 3: 半導体素子

第 2 図 (々の1)